

Программа Девятой Международной конференции

«Достижения Китайской электронной промышленности в производстве высоконадежной ЭКБ для применения в космической промышленности»

23-24 апреля 2024 г.

г. Москва

Место проведения: ИКИ РАН (м. «Калужская»).

Адрес: 117997, г. Москва, ул. Профсоюзная 84/32

Схема проезда: <http://www.iki.rssi.ru/proezd.htm>

23 апреля, вторник		
1	9:00-10:00	Регистрация участников
2	10:00	Открытие конференции
3	10:30	Доклад: «Внутрисогласованные транзисторы, монокристаллы и гибридные СВЧ МИС на основе GaN, GaAs от изготовителей METDA и Neditek, IC Valley.»
4	11:00	Доклад: «Дискретные полупроводниковые компоненты, аналоговые ИС по монокристалльной и гибридной технологии Сианьского института микроэлектронной техники (ХМТИ).»
5	11:30	Кофе-брейк
6	12:00	Доклад: «ПЛИС, АЦП, ЦАП, Flash память и др. цифровые компоненты ведущих Китайских изготовителей.»
8	12:50	Доклад: «Поддержка ПЛИС из КНР периферийного сканирования: первые результаты верификации и ожидания рынка.»
9	13:20	Доклад: Камера машинного зрения на основе Fudan и Gpixel. Проблемы с применением JFMK50T4 и их решение. Миграция проекта с Fudan на PangoMicro.
10	13:40	Обеденный перерыв
11	14:30	Экскурсия по Выставочному залу ИКИ РАН
12	15:00	Доклад испытательного центра о практике и опыте испытаний ЭКБ КНР, порядке сертификации ЭКБ КНР
13	15:30	Доклад: «Обзор САПР с открытым кодом (open source) для мировых производителей ПЛИС.»
14	16:00	Перерыв
15	16:15	Доклад на тему: «Высоконадежные пассивные компоненты (конденсаторы, резисторы, предохранители, фильтры) для ответственных применений компании Omicron.»
16	16:45	Доклад: «Модули памяти по технологии 3Д от компании ORBITA и ХМТИ.»
17	17:15	Доклад на тему: «Кварцевые резонаторы, генераторы и фильтры для космического и военного применений Пекинского Института Радиоэлектронных Измерений (BIRMM).»
18	17:45	Подведение итогов. Заключительное слово.

24 апреля, среда	
9:00-17:00	Работа по секции «ПЛИС, ЦАП, АЦП.»
9:00-17:00	Работа по секции «Бескорпусные усилители мощности на основе GaN и GaAs, внутрисогласованные СВЧ транзисторы на основе GaN.»
9:00-17:00	Работа по секции «100В ВИП, 27В ВИП, N и P каналные транзисторы.»
9:00-17:00	Работа по секции «Пассивные и электромеханические ЭРИ (конденсаторы, фильтры, резисторы, соединители, кабельные сборки, электромеханические реле).»

Работа в секции – это персональные встречи специалистов Российских заказчиков с техническими специалистами АО «Эпсилон». В ходе этой встречи специалисты будут ознакомлены с продукцией, детально обсудят технические вопросы и конкретные технические решения и задачи.

Для участия в работе секции необходима предварительная регистрация.

Контактное лицо по организации работы в секции: Пищалкина Анна Валерьевна +7-911-740-73-96 или

Игуменова Татьяна Олеговна +7-981-760-03-22